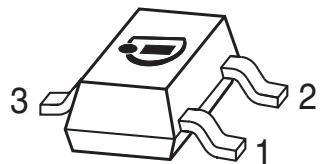


### PNP Silicon Switching Transistor

- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary type:  
SMBT2222A / MMBT2222A (NPN)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



Type	Marking	Pin Configuration			Package
SMBT2907A/MMBT2907A	s2F	1 = B	2 = E	3 = C	SOT23

### Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CEO}$	60	V
Collector-base voltage	$V_{CBO}$	60	
Emitter-base voltage	$V_{EBO}$	5	
Collector current	$I_C$	600	mA
Base current	$I_B$	100	
Peak base current	$I_{BM}$	200	
Total power dissipation	$P_{tot}$	330	mW
$T_S \leq 77 \text{ } ^\circ\text{C}$			
Junction temperature	$T_j$	150	
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150	$^\circ\text{C}$

### Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$	$\leq 220$	K/W

<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

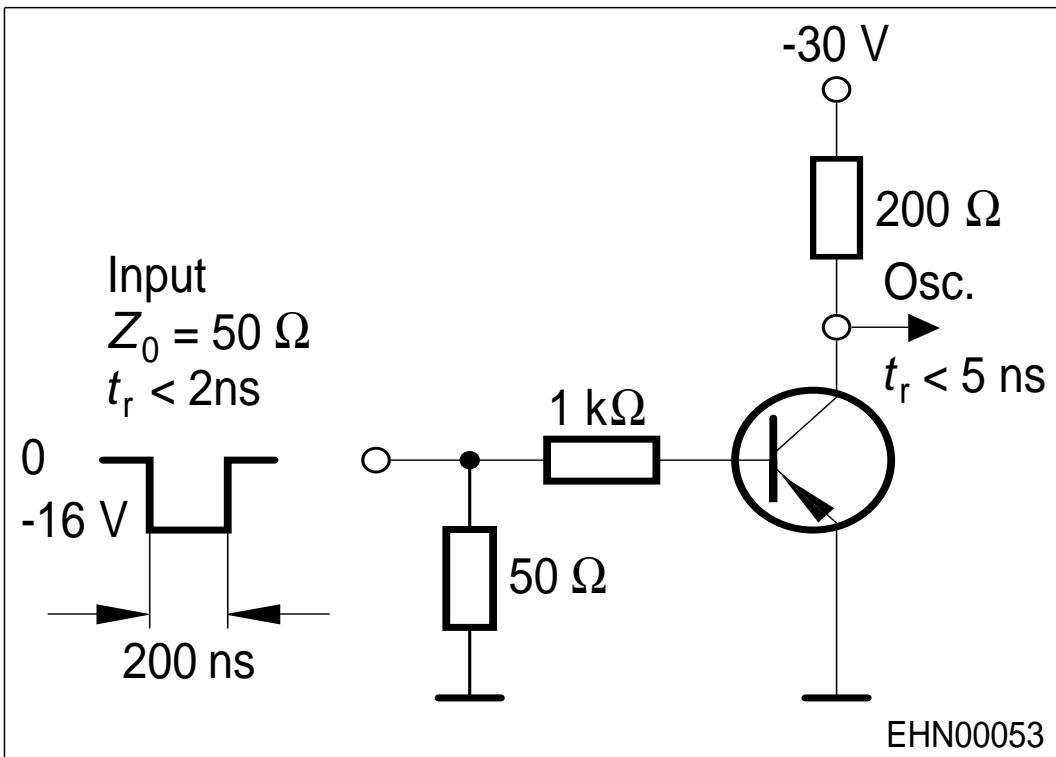
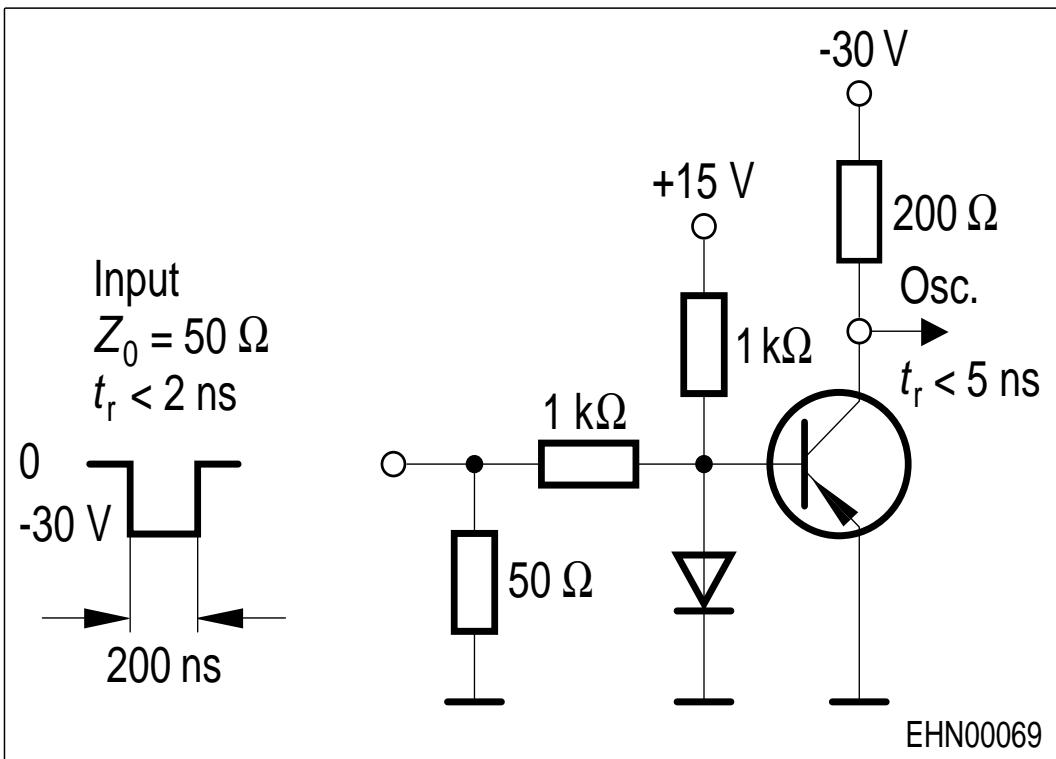
**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	60	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10 \mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	60	-	-	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10 \mu\text{A}, I_C = 0$	$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	5	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 50 \text{ V}, I_E = 0$ $V_{CB} = 50 \text{ V}, I_E = 0, T_A = 150^\circ\text{C}$	$I_{\text{CBO}}$	-	-	0.01 10	$\mu\text{A}$
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 5 \text{ V}, I_C = 0$	$I_{\text{EBO}}$	-	-	10	nA
DC current gain <sup>1)</sup> $I_C = 100 \mu\text{A}, V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 150 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 500 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$	$h_{\text{FE}}$	75 100 100 100 50	- - - -	- - - 300 -	-
Collector-emitter saturation voltage <sup>1)</sup> $I_C = 150 \text{ mA}, I_B = 15 \text{ mA}$ $I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$	$V_{\text{CEsat}}$	- -	- -	0.4 1.6	V
Base emitter saturation voltage <sup>-1)</sup> $I_C = 150 \text{ mA}, I_B = 15 \text{ mA}$ $I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$	$V_{\text{BEsat}}$	- -	- -	1.3 2.6	

<sup>1)Puls test:  $t \leq 300\mu\text{s}$ , D = 2%</sup>

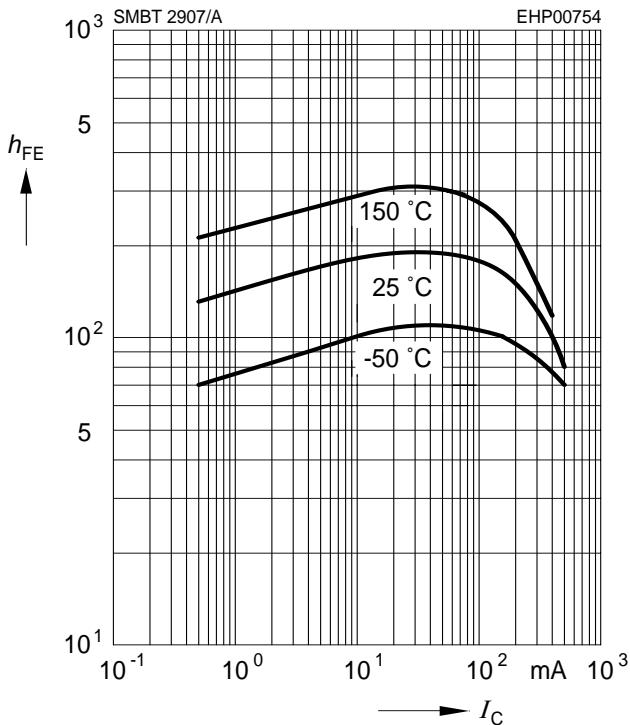
**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>AC Characteristics</b>					
Transition frequency $I_C = 20 \text{ mA}, V_{CE} = 20 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	200	-	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	$C_{cb}$	-	-	8	pF
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	$C_{eb}$	-	-	30	
Delay time $V_{CC} = 30 \text{ V}, I_C = 150 \text{ mA}, I_{B1} = 15 \text{ mA}, V_{BE(\text{off})} = 0.5 \text{ V}$	$t_d$	-	-	10	ns
Rise time $V_{CC} = 30 \text{ V}, I_C = 150 \text{ mA}, I_{B1} = 15 \text{ mA}, V_{BE(\text{off})} = 0.5 \text{ V}$	$t_r$	-	-	40	
Storage time $V_{CC} = 30 \text{ V}, I_C = 150 \text{ mA}, I_{B1} = I_{B2} = 15 \text{ mA}$	$t_{stg}$	-	-	80	
Fall time $V_{CC} = 30 \text{ V}, I_C = 150 \text{ mA}, I_{B1} = I_{B2} = 15 \text{ mA}$	$t_f$	-	-	30	

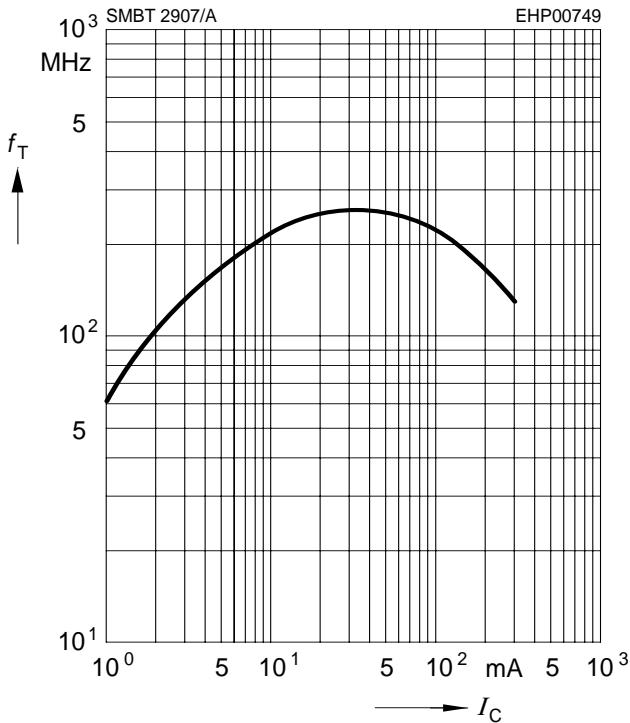
**Test circuit**
**Delay and rise time**

**Storage and fall time**


**Oscillograph:**  $R > 100$ ,  $C < 12\text{pF}$ ,  $t_r < 5\text{ns}$

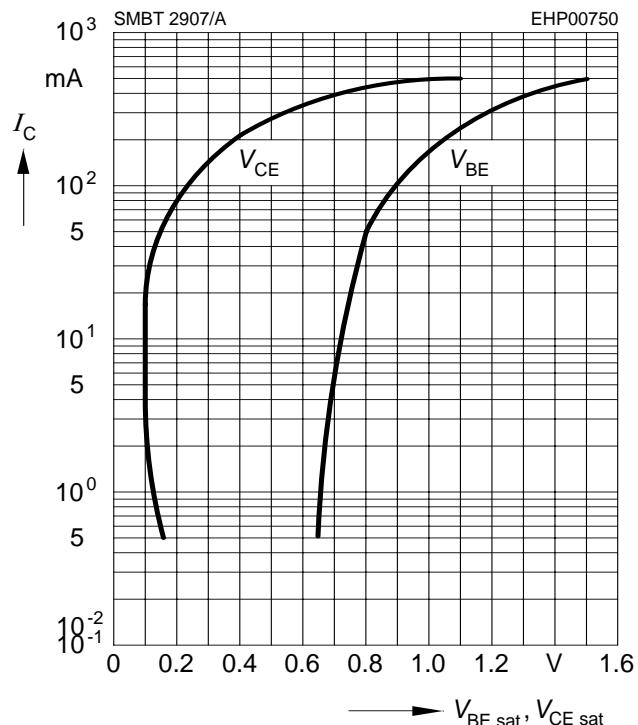
**DC current gain**  $h_{FE} = f(I_C)$   
 $V_{CE} = 5 \text{ V}$



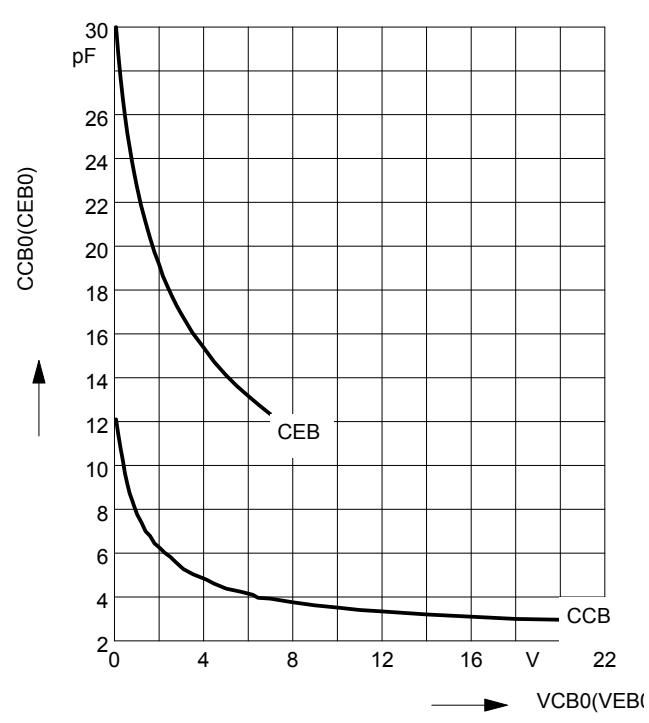
**Transition frequency**  $f_T = f(I_C)$   
 $V_{CE} = 5 \text{ V}$



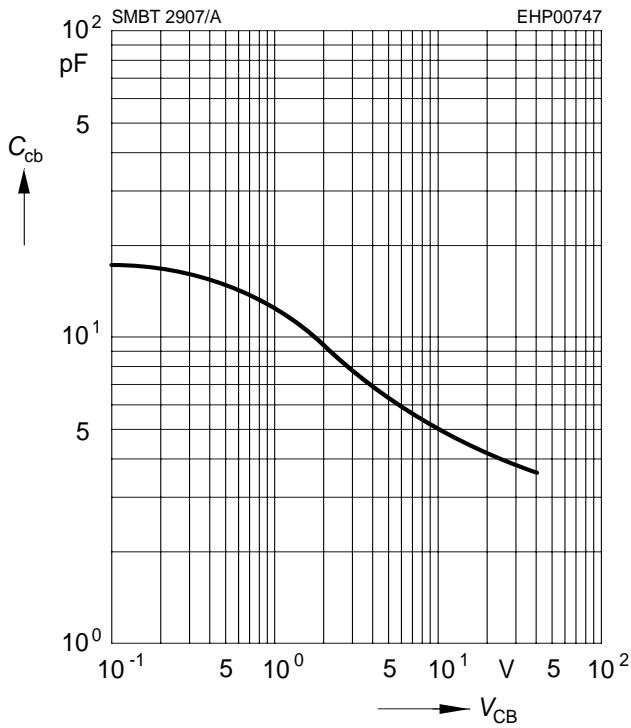
**Saturation voltage**  $I_C = f(V_{BEsat}, V_{CESat})$   
 $h_{FE} = 10$



**Collector-base capacitance**  $C_{cb} = f(V_{CB})$   
**Emitter-base capacitance**  $C_{eb} = f(V_{EB})$

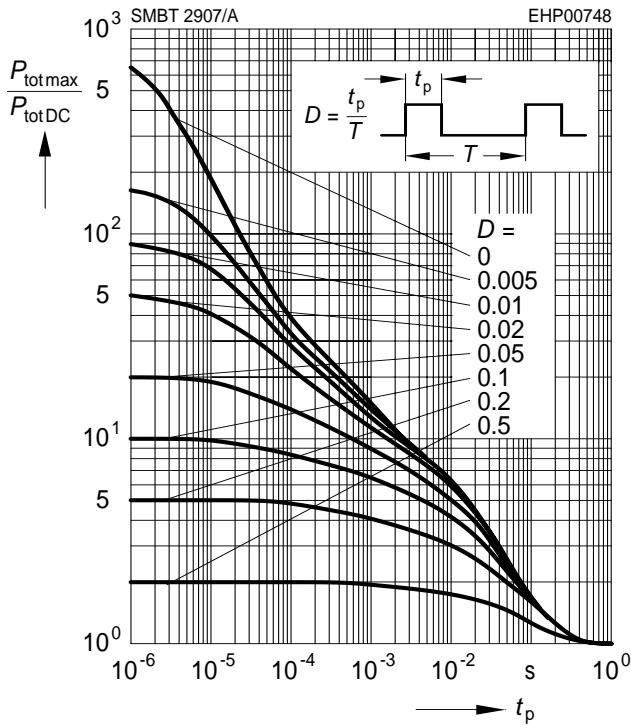


**Collector-base capacitance  $C_{CB} = f(V_{CB})$**   
 $f = 1\text{MHz}$

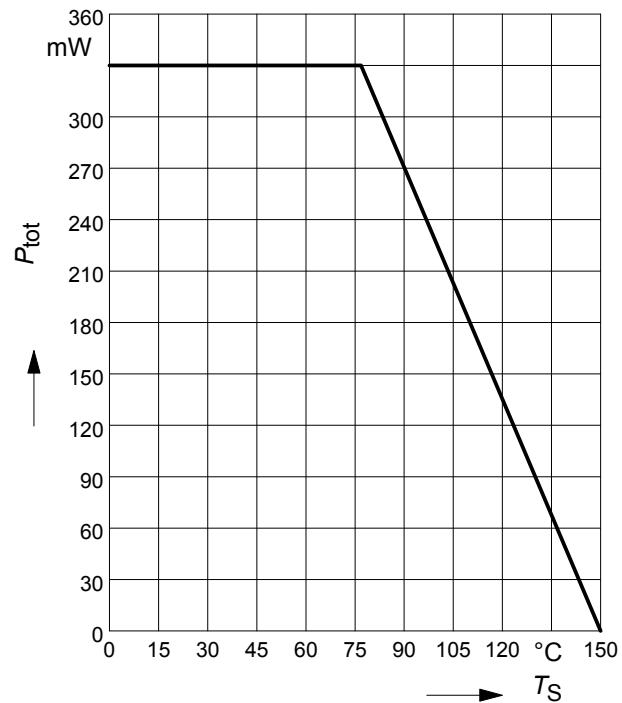


### Permissible Pulse Load

$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$

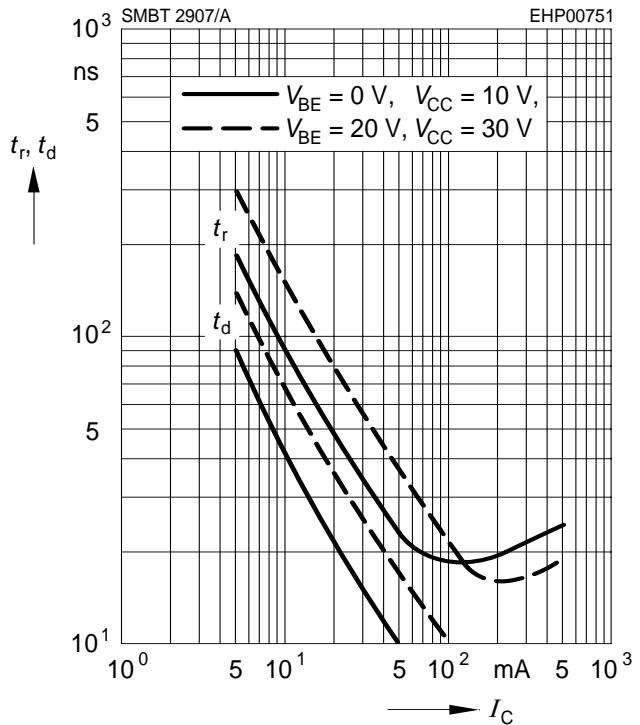


**Total power dissipation  $P_{\text{tot}} = f(T_S)$**

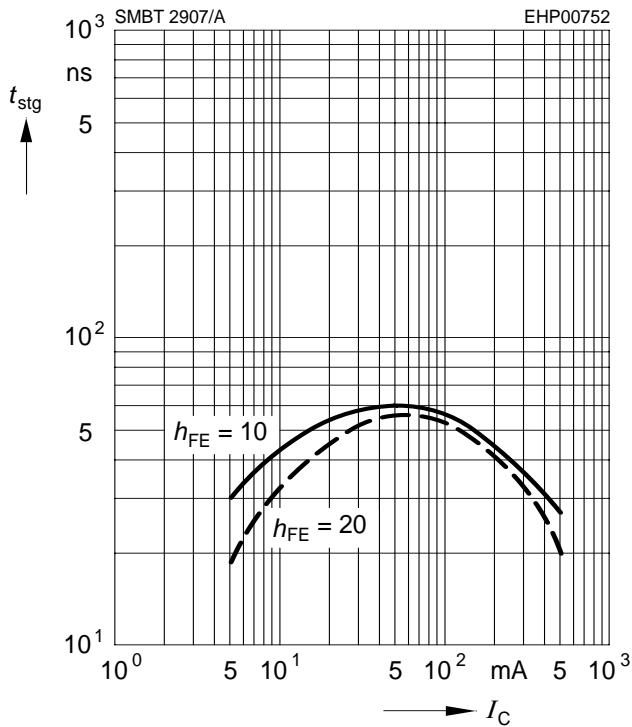


**Delay time  $t_d = f(I_C)$**

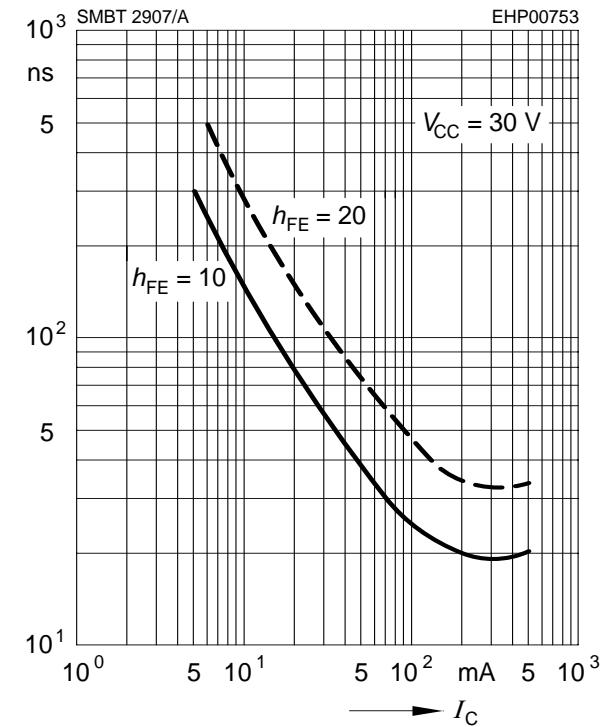
**Rise time  $t_r = f(I_C)$**



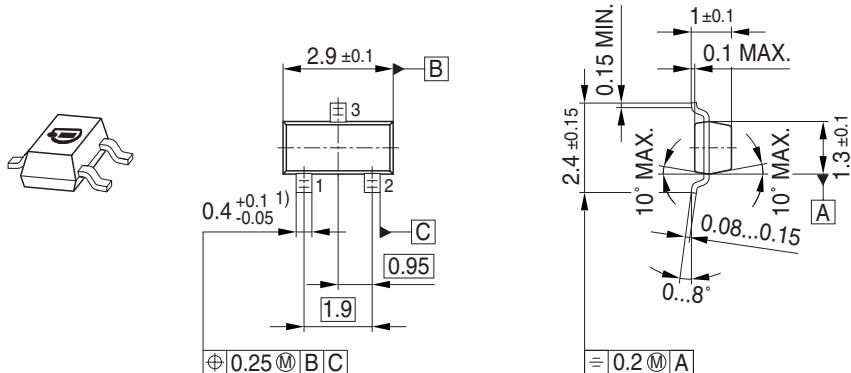
**Storage time  $t_{\text{stg}} = f(I_C)$**



**Fall time  $t_f = f(I_C)$**

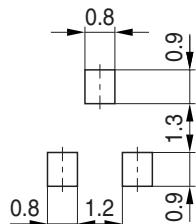


## Package Outline

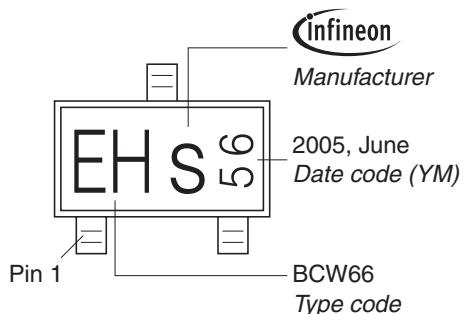


1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

## Foot Print

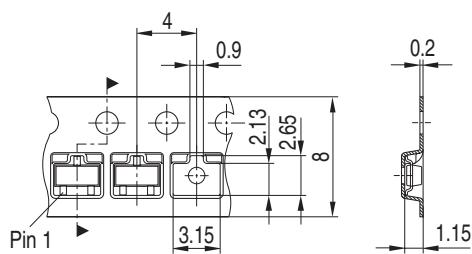


## Marking Layout (Example)



## Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



**Edition 2009-11-16**

**Published by**  
**Infineon Technologies AG**  
**81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG**  
**All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331